



高效的简易驱动型 P沟道MOSFET

30V P沟道MOSFET

产品型号	封装	最大 I_D @ TA=25°C (A)	最大 V_{GS} (V)	最大 $R_{DS(on)}$ $V_{GS} = @10V$ (mΩ)	最大 $R_{DS(on)}$ $V_{GS} = @4.5V$ (mΩ)
IRF9310	SO-8	20	20	3.9 / 4.6	5.8 / 6.8
IRF9317	SO-8	16	20	5.4 / 6.6	8.3 / 10.2
IRF9321	SO-8	15	20	5.9 / 7.2	9.3 / 11.2
IRF9328	SO-8	12	20	10.0 / 11.9	16.1 / 19.7
IRF9332	SO-8	9.8	20	13.6 / 17.5	22.5 / 28.1
IRF9333	SO-8	9.2	20	15.6 / 19.4	25.6 / 32.5
IRF9335	SO-8	5.4	20	48 / 59	83 / 110
IRF9362	SO-8 (双)	8	20	17.0 / 21.0	25.7 / 32
IRLML9301	SOT-23	3.6	20	51 / 64	82 / 103
IRLML9303	SOT-23	2.3	20	135 / 165	220 / 270

特性

- 20V V_{GS}
- 当 $V_{GS} = 10V$ 时， $R_{DS(on)}$ 的最大值低至4.6mΩ
- 行业标准的SO-8和SOT-23封装
- 符合消费类标准，MSL1
- 符合RoHS标准，无铅、无溴，无卤

IR的优势

- 最小型的高端驱动电路
- 理想用于采用12-20V总线的计算应用
- 更低的导通损耗
- 多厂商产品的兼容性
- 提高了稳定性
- 环保型产品

www.irf.com

www.irf.com.cn

为您实现所需性能
的最佳选择!

如有任何查询，请利用 IR 网上 [客户关系管理] 回执与我们联系。
网址：www.irf.com.cn/contact。

* 根据2010年8月所编译的数据资料

International
IR Rectifier
THE POWER MANAGEMENT LEADER